

Сведения о члене экспертной комиссии

1	ФИО (полностью)	Карасёв Платон Александрович
2	Дата рождения (полная)	05.11.1972 г
3	Гражданство	Российская Федерация
4	Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	Доктор физико-математических наук, 01.04.04 физическая электроника 01.04.10 физика полупроводников
5	Ученое звание (по кафедре, специальности)	Доцент
6	Место работы:	
	Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29 <a href="https://www.spbstu.ru">https://www.spbstu.ru</a>
	Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».
	Ведомственная принадлежность организации	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
	Тип организации	Автономное учреждение
	Наименование подразделения	Высшая инженерно-физическая школа
	Должность	Профессор
7	<p>Основные публикации в области диссертационного исследования (для членов, представляющих технические науки: не менее 7 научных статей за последние 5 лет в изданиях из перечня ВАК, из которых не менее 2-х в Scopus/WoS; для членов, представляющих физико-математические науки: не менее 8 научных статей за последние 5 лет в изданиях из перечня ВАК, из которых не менее 3-х в Scopus/WoS; для членов, представляющих экономические науки: не менее 6 научных статей за последние 5 лет в изданиях из перечня ВАК, из которых не менее 1 в WoS/Scopus, а также не менее 1 рецензируемой монографии):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A. Azarov, V. Venkatachalapathy, <b>P. Karasev</b>, A. Titov, K. Karabeshkin, A. Struchkov, A. Kuznetsov. Interplay of the disorder and strain in gallium oxide // Scientific Reports, volume 12, Article number: 15366 (2022).</li> <li>2. <b>П.А. Карасев</b>, К.В. Карабешкин, А.И. Стручков, А.И. Печников, В.И. Николаев, В.Д. Андреева, А.И. Титов, Накопление структурных нарушений при облучении <math>\alpha</math>-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ионами Р и PF<sub>4</sub>//Физика и техника полупроводников, том 56, вып. 9, с. 882 (2022).</li> <li>3. A.I. Titov, K.V. Karabeshkin, A.I. Struchkov, V.I. Nikolaev, A. Azarov, D.S. Gogova, <b>P.A. Karasev</b>. Comparative study of radiation tolerance of GaN and Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> polymorphs // Vacuum, Volume 200, 111005 (2022).</li> <li>4. Titov A.I., Karabeshkin K.V., Truchkov A.I., <b>Karasev P.A.</b> Radiation tolerance of GaN: The balance between radiation-stimulated defect annealing and defect stabilization by implanted atoms// Journal of Physics D: Applied Physics, 55, 175103 (2022).</li> <li>5. K.V. Karabeshkin, A.I. Struchkov, A.I. Titov, A. Azarov, D.S. Gogova, <b>P.A. Karasev</b>. Molecular Effect in Damage Formation in <math>\beta</math>-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>// International Youth Conference on Electronics, Telecommunications and Information Technologies pp 255–262 (2022).</li> <li>6. <b>Карасев П.А.</b>, Карабешкин К.В., Стручков А.И., Печников А.И., Николаев В.И., Андреев В.И., Титов А.И. Уакопление структурных нарушений при облучении <math>\alpha</math>-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ионами Р И PF<sub>4</sub>// физика и техника полупроводников, 56, 9, с. 882-887 (2022).</li> <li>7. Titov A.I., <b>Karasev P.A.</b>, Karabeshkin K V., Struchkov A.I. The formation of radiation damage in GaN during successive bombardment by light ions of various energies // Vacuum, 173, 109149 (2020).</li> </ol>	

	8. А.И. Титов, К.В. Карабешкин, <b>П.А. Карасев</b> , А.И. Стручков. Влияют ли химические эффекты на накопление структурных нарушений при имплантации в GaN ионов фтора? // Физика и техника полупроводников, том 53, вып11, с. 1455 (2019).
8	Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный)
9	Адрес электронной почты